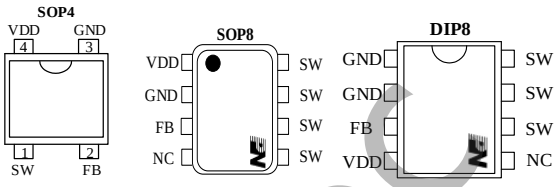
PN8007,PN8008,PN8009应用设计指导

1. 概述

PN8007/08/09系列集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET，用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8007/08/09内置650V高压启动模块，实现系统快速启动、超低待机功能。

同时，该芯片提供了完整的智能化保护功能，包括过载保护，欠压保护，过温保护。另外PN8007/08/09的降频调制技术有助于改善EMI特性。



订购代码	封装	典型功率
PN8007SEC-R1B	SOP8	0.75W(5V150mA)
PN8008SY-L1	SOP4	1.5W(5V300mA)
PN8008SE-A1	SOP8	1.5W(5V300mA)
PN8008NE-A1	DIP8	1.5W(5V300mA)
PN8009LSE-A1	SOP8	2.0W(5V400mA)
PN8009SE-A1	SOP8	2.5W(5V500mA)
PN8009SE-A2	SOP8	2.5W(5V500mA)

2. 特性

- 内置650V高可靠性MOSFET
- 内置高压启动
- 适用于Buck、Buck-Boost架构
- 输出电压固定为5V
- 半封闭式稳态输出电流能力150~500mA @230V_{AC}
- 改善EMI的降频调制技术
- 优异的负载调整率和工作效率
- 全面的保护功能
  - ✧ 过载保护（OLP）
  - ✧ 逐周期过流保护（OCP）
  - ✧ 过温保护（OTP）
  - ✧ FB异常保护

非格芯有限公司 Reference Spec